

Gassoumi M.

Characterization of Deep Levels in AlGaIn/GaN HEMT by FT-DLTS and Current DLTS 1099

• **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б.

Физико-химические взаимодействия в системе $\text{GeSb}_2\text{Te}_4\text{—PbSb}_2\text{Te}_4$ 1100

Марков Л.К., Смирнова И.П., Кукушкин М.В., Павлюченко А.С.

Комбинация плазмохимического и жидкостного травления как способ оптимизации рельефа на поверхности AlGaInN-гетероструктур 1106

Сресели О.М., Елистратова М.А., Горячев Д.Н., Берегулин Е.В., Неведомский В.Н., Берт Н.А., Ершов А.В.

Электрические и фотоэлектрические свойства многослойных наноструктур $\alpha\text{-Si/SiO}_2$ и $\alpha\text{-Ge/SiO}_2$ на подложках $p\text{-Si}$, отожженных при разных температурах 1112

• **XXIV Международный симпозиум „Нанозлектроника“, Нижний Новгород, 10–13 марта 2020 г.**

Сибирев Н.В., Бердников Ю.С., Сибирев В.Н.

Изменение кристаллической фазы в гетероструктурных Ga(As, P) нитевидных нанокристаллах под воздействием упругих напряжений 1117

Климов А.Э., Акимов А.Н., Ахундов И.О., Голяшов В.А., Горшков Д.В., Ищенко Д.В., Матюшенко Е.В., Неизвестный И.Г., Сидоров Г.Ю., Супрун С.П., Тарасов А.С., Терещенко О.Е., Эпов В.С.

Особенности МДП-структур на основе изолирующих пленок PbSnTe:In с составом вблизи инверсии зон, обусловленные их сегнетоэлектрическими свойствами 1122

Сушков А.А., Павлов Д.А., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Крюков Р.Н., Питиримова Е.А.

Наращивание слоя Ge на структуру $\text{Si/SiO}_2/\text{Si}$ (100) методом „горячей проволоки“ 1129

Ежевский А.А., Сенников П.Г., Гусейнов Д.В., Сухо-руков А.В., Калинина Е.А., Абросимов Н.В.

Поведение доноров лития в объемных монокристаллических моноизотопных сплавах $^{28}\text{Si}_{1-x}^{72}\text{Ge}_x$ 1134

Дорохин М.В., Демина П.Б., Данилов Ю.А., Вихрова О.В., Кузнецов Ю.М., Ведь М.В., Iikawa F., Balanta M.A.G.

Фотолюминесценция с временным разрешением в гетероструктурах с квантовыми ямами InGaAs:Cr/GaAs 1139

Ковалевский К.А., Чопорова Ю.Ю., Жукавин Р.Х., Абросимов Н.В., Павлов С.Г., Hübers H.-W., Цыпленков В.В., Кукотенко В.Д., Князев Б.А., Шастин В.Н.

Релаксация возбужденных состояний мышьяка в деформированном германии 1145

Яблонский А.Н., Новиков А.В., Степихова М.В., Сергеев С.М., Байдакова Н.А., Шалеев М.В., Красильник З.Ф.

Кинетика люминесцентного отклика самоформирующихся наноструктур Ge(Si), встроенных в двумерные фотонные кристаллы 1150

Дюков Д.И., Фефелов А.Г., Коротков А.В., Павельев Д.Г., Козлов В.А., Оболенская Е.С., Иванов А.С., Оболенский С.В.

Сравнение эффективности перспективных гетероструктурных умножительных диодов терагерцового диапазона частот 1158

Кушков Л.А., Уточкин В.В., Алёшкин В.Я, Дубинов А.А., Кудрявцев К.Е., Гавриленко В.И., Куликов Н.С., Фадеев М.А., Румянцев В.В., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Разова А.А., Морозов С.В.

Исследование стимулированного излучения в гетероструктурах с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe в окне прозрачности атмосферы 3–5 мкм 1163

Уточкин В.В., Алёшкин В.Я., Дубинов А.А., Гавриленко В.И., Куликов Н.С., Фадеев М.А., Румянцев В.В., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Разова А.А., Морозов С.В.

Непрерывное стимулированное излучение в области 10–14 мкм при оптической накачке в структурах с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe с квазирелятивистским законом дисперсии 1169

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Российская академия наук
Ленинский пр., 14, Москва, 199000
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук
Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021
Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017
post@mail.ioffe.ru <http://www.ioffe.ru>

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
Регистрационный номер ПИ № ФС77-71300 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
semicond@mail.ioffe.ru
<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>

Зав. редакцией *С. Б. Короткова*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 30.09.2020. Дата выхода в свет 30.10.2020.
Формат 60×90 1/8.
Усл. печ. л. 23.7. Уч.-изд. л. 22.5.
Тираж 58 экз.
Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов
в полиграфическом центре ФГУП Издательство „Известия“
127254, Москва, ул. Добролюбова, 6
телефон: (495)650-3880, <http://izv-udprf.ru>